

2SA564, 2SA564A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形

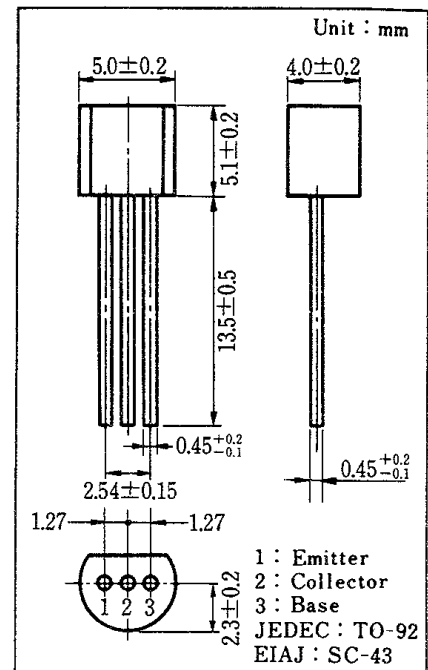
一般増幅用

■ 特長

- 直流電流増幅率 h_{FE} が大きい。

■ 絶対最大定格 (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	2SA564 -25	V
2SA564A -45			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	2SA564 -25	V
2SA564A -45			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-200	mA
コレクタ電流	I_C	-100	mA
コレクタ損失	P_C	400	mW
接合部温度	T_J	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C



■ 電気的特性 (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -20 V, I_E = 0$			-1	μA
	I_{CEO}	$V_{CE} = -20 V, I_B = 0$			-10	
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = -10 \mu A, I_E = 0$	2SA564	-25		V
			2SA564A	-45		
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = -2 mA, I_B = 0$	2SA564	-25		V
			2SA564A	-45		
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = -10 \mu A, I_C = 0$	-7			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE} = -5 V, I_C = -2 mA$	130		520	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -50 mA, I_B = -2.5 mA$			-1	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = -10 V, I_E = 1 mA, f = 200 MHz$		200		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10 V, I_E = 0, f = 1 MHz$		3.5		pF

* h_{FE} ランク分類

ランク	Q	R	S
h_{FE}	130~260	180~360	260~520

